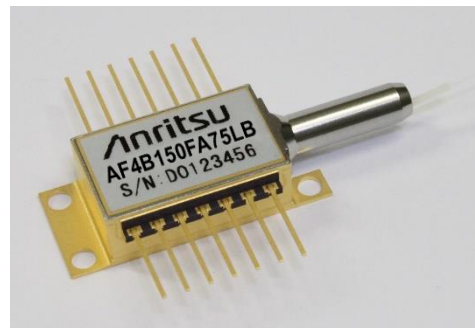


1.48 μm LD モジュール AF4B150FA75LB/FD75LB

AF4B150FA75LB/FD75LBは、エルビウムドープファイバアンプの励起用光源として開発された1.48 μm 帯高出力・低消費電力FP-LDモジュールです。

特長

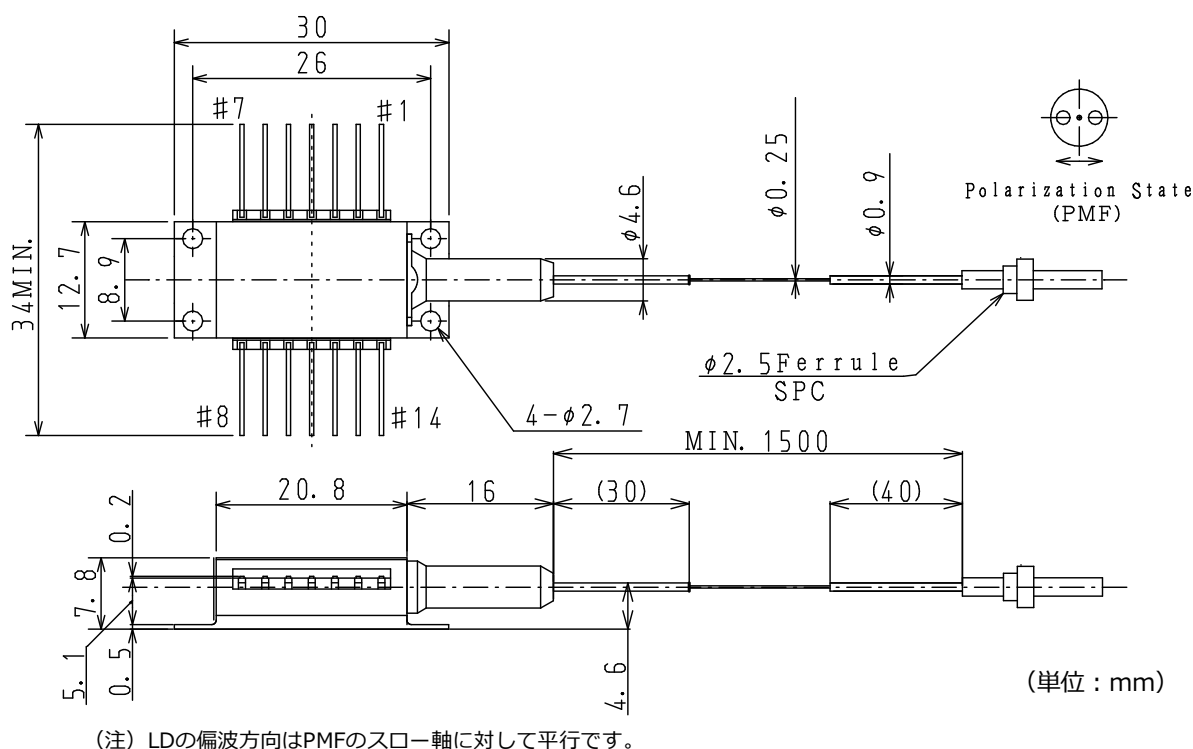
- ・ 光出力 : 500 mW
- ・ ファイバ :
AF4B150FA75LB ; シングルモードファイバ (SMF)
AF4B150FD75LB ; 偏波保持ファイバ (PMF)
- ・ 14ピンバタフライパッケージ
- ・ 光アイソレータ、モニタPD、クーラ内蔵
- ・ LD動作温度 35℃



用途

- ・ EDFA励起用光源

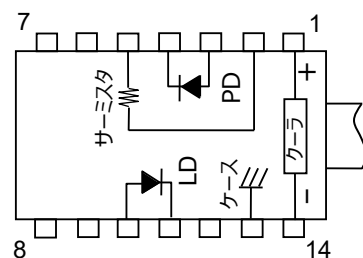
外形寸法



端子接続

No.	FUNCTION	No.	FUNCTION
1	クーラアノード	8	NC
2	サーミスタ	9	NC
3	PDアノード	10	LDアノード
4	PDカソード	11	LDカソード
5	サーミスタ	12	NC
6	NC	13	ケース
7	NC	14	クーラカソード

TOP VIEW



絶対最大定格

項目	記号	定格	単位
LD 順電流	I_F	2200	mA
LD 逆電圧	V_R	2	V
PD 順電流	I_{FD}	10	mA
PD 逆電圧	V_{RD}	20	V
動作ケース温度	T_C	-5 to +70	°C
保存温度	T_{stg}	-40 to +85	°C
クーラ電流	I_C	5.8	A

*絶対最大定格を超えると故障の原因になることがあります。

電氣的・光学的特性 ($T_{LD} = 35^\circ\text{C}$, $T_C = 25^\circ\text{C}$)

項目	記号	測定条件	Min.	Typ.	Max.	単位
順電圧	V_F	$P_f = 500 \text{ mW}$, BOL	–	–	2.2	V
しきい値電流	I_{th}	–	–	–	180	mA
順電流	I_F	$P_f = 500 \text{ mW}$, BOL	–	–	1875	mA
中心波長	λ_C	$P_f = 500 \text{ mW}$, RMS (-20 dB)	1460	1475	1490	nm
スペクトル幅	$\Delta\lambda$	$P_f = 500 \text{ mW}$, RMS (-20 dB)	–	5	10	nm
モニタ電流	I_m	$P_f = 500 \text{ mW}$, $V_{RD}=5\text{V}$	100	–	2000	μA
PD 暗電流	I_d	$V_{RD} = 5\text{V}$	–	–	0.1	μA
トラッキングエラー	ΔP_f	$I_m = \text{const.}$, $T_C = -5 \text{ to } 70^\circ\text{C}$	-0.5	–	0.5	dB
クーラ電圧	V_C	$I_F = \text{EOL}^{*1}$, $T_C = 70^\circ\text{C}$	–	–	3.0	V
クーラ電流	I_C	$I_F = \text{EOL}^{*1}$, $T_C = 70^\circ\text{C}$	–	–	2.5	A
サーミスタ抵抗	R_{th}	$T_{LD} = 35^\circ\text{C}$, $B = 3900 \pm 100 \text{ K}$	6.0	6.5	7.0	$\text{k}\Omega$
アイソレーション	R_O	$T_{LD} = 35^\circ\text{C}$	–	30	–	dB
偏波消光比 ^{*2}	X_P	$P_f = 500 \text{ mW}$	17	–	–	dB

*1 $\text{EOL} = \text{BOL} \times 1.15$

*2 PMF品に適用されます。



CAUTION : Handle the fiber of the enclosed device(s) with extreme care ; glass fiber is subject to breakage if mishandled and permanent damage to the device may result. Do not pull the device by the fiber or protective sleeve.
Do not coil the fiber into a loop of than 30 mm in radius.

SEMICONDUCTOR LASER AVOID EXPOSURE Invisible laser radiation is emitted from this aperture	DANGER INVISIBLE LASER RADIATION AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION OUTPUT POWER 800mW WAVELENGTH 0.80 to 1.80 μm CLASS IV LASER PRODUCT
Caution - use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. This Product Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 Manufactured Anritsu Corp. 5-1-1 Onna, Atsugi-shi, Kanagawa, Japan	

アンリツ株式会社

センシング&デバイスカンパニー 営業部
<https://www.anritsu.com/sensing-devices>

〒243-8555 神奈川県厚木市恩名5-1-1
TEL 046-296-6783 FAX 046-225-8390



お問い合わせURL
<https://www.anritsu.com/ja-jp/sensing-devices/contact-us>

ご使用の前に「光デバイス取扱い上の注意点」をお読みください。
<https://www.anritsu.com/ja-jp/sensing-devices/guide/optdevices-handling>



■本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要になる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。

■記載事項はお断りなしに変更することがあります。